

2SB1163

シリコン PNP プレーナ形 / Si PNP Planar

大電力増幅用 / High Power Amplifier

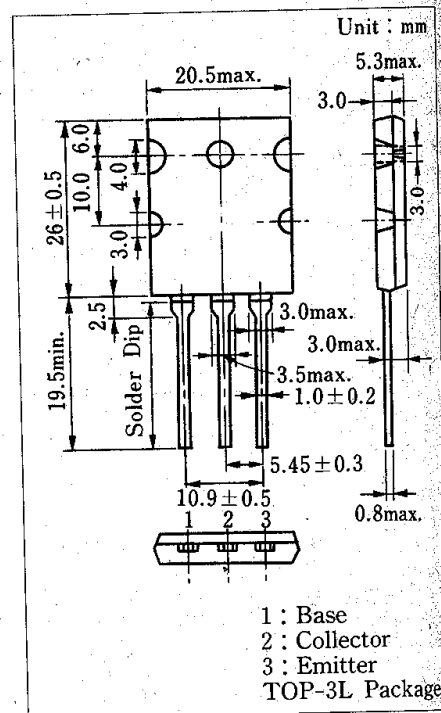
2SD1718 とコンプリメンタリ / Complementary Pair with 2SD1718

■ 特徴 / Features

- 直流電流増幅率 h_{FE} の直線性が極めてよい。
Exceptionally good linearity of h_{FE}
- 安全動作領域 (ASO) が広い。 / Wide area of safe operation (ASO)
- トランジション周波数 f_T が高い。 / High f_T

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	-180	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-180	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	-25	A
コレクタ電流	I_C	-15	A
コレクタ損失	P_C	$T_c=25^\circ\text{C}$	150
		$T_a=25^\circ\text{C}$	3.5
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -180\text{V}, I_E = 0$			-50	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -3\text{V}, I_C = 0$			-50	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -20\text{mA}$	20			
	h_{FE2}^*	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -1\text{A}$	60			
	h_{FE3}	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -8\text{A}$	20			
ベース・エミッタ飽和電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -8\text{A}$			-1.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -10\text{A}, I_B = -1\text{A}$			-2.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -0.5\text{A}$		20		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 0, f = 1\text{MHz}$		230		pF

* h_{FE2} ランク分類 / h_{FE2} Classifications

Class	Q	S	P
h_{FE2}	60~100	80~160	100~200